



1) powierzchnia aktywna, 2) Strefa wolna, 3) patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
EN 55022	Gr.1,KI.B
Kształt anteny	okrągły
Zasada działania	Nośnik danych

Electrical data

Cykle odczytu	bez ograniczeń
Cykle programowania	≤ 100.000
Czas przechowywania danych / lata	≥ 50 przy 55 °C
Organizacja pamięci	28 × 4 bits

Environmental conditions

Ciągłe obciążenie udarowe	tak
EN 60068-2-27 szok	tak
EN 60068-2-32 Swobodny upadek	tak
EN 60068-2-6 wibracja	tak
Stopień ochrony	IPx8
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Temperatura przechowywania	-40...85 °C

Functional Characteristics

Numer seryjny UID, tylko do odczytu	8 Byte
Obsługiwane typy nośników danych	DIN ISO 15693
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis	112 Byte
Typ pamięci	EEPROM

Functional safety

MTTF (40 °C)	109 a
--------------	-------

Material

Materiał obudowy	Żywica epoksydowa wzmocniana włóknem szklanym PVC
------------------	---

Mechanical data

Montaż	bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Wymiary	∅ 4.35 x 3.6 mm
Średnica, tolerancja	±0.05 mm

HF (13.56 MHz)
BIS M-113-03/L
Kod artykułu: BIS018Y

BALLUFF

Remarks

Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.
Tylko w połączeniu z przewidzianą głowicą zapisu/odczytu.
Warunki zastosowania patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu.
Obciążenia skrętne, zginające i udarowe są niedopuszczalne.
Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.